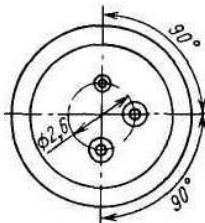
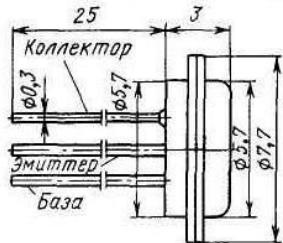


2T301Г, 2T301Д, 2T301Е, 2T301Ж, КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж

Транзисторы кремниевые планарные и-р-п универсальные высокочастотные маломощные
Предназначены для применения в усилительных и генераторных схемах радиоэлектронной аппаратуры
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на корпусе.
Масса транзистора не более 0,5 г.



Электрические параметры

Максимальная частота генерации при $U_{KB} = 10$ В, $I_3 = 3$ мА не менее 60 МГц

Модуль коэффициента передачи тока при $U_{KE} = 10$ В, $I_3 = 3$ мА, $f = 20$ МГц не менее 1,5

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{KB} = 10$ В, $I_3 = 2$ мА, $f = 2$ МГц не более

2T301Г, 2T301Д, КТ301Г, КТ301Д 4,5 нс
2T301Е, 2T301Ж, КТ301Е, КТ301Ж 2,0 нс

Время рассасывания при $I_k = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более

2T301Г, 2T301Д, КТ301Г, КТ301Д 5 мкс
2T301Е, 2T301Ж, КТ301Е, КТ301Ж 8 мкс

Коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 10$ В, $I_3 = 3$ мА:

2T301Г, КТ301Г	10 – 32
2T301Д, КТ301Д	20 – 60
2T301Е, КТ301Е	40 – 120
2T301Ж, КТ301Ж	80 – 300

Границное напряжение при $I_3 = 10$ мА, $t_u = 5$ мкс не менее

2T301Г, 2T301Д	30 В
2T301Е, 2T301Ж	20 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более 3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более 2,5 В

Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 10$ В, $f = 2$ МГц не более 10 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{EB} = 0,5$ В, $f = 2$ МГц не более 80 пФ

Обратный ток коллектора

при $T = 298$ К $U_{KB} = U_{KB\max}$ не более
2T301Г, 2T301Д, 2T301Е, 2T301Ж 5 мкА

КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж 10 мкА

при $T = 398$ К $U_{KB} = 10$ В не более
2T301Г, 2T301Д, 2T301Е, 2T301Ж 50 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 3$ В не более
2T301Г, 2T301Д, 2T301Е, 2T301Ж 50 мкА

КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж 10 мкА

Выходная проводимость при $U_{KB} = 10$ В, $I_3 = 3$ мА, $f = 1$ кГц не более 3,0 мкСм

Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер

2T301Г, 2T301Д, КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж

30 В

2T301Е, 2T301Ж

20 В

3 В

Напряжение эмиттер база

2 В

Постоянный ток коллектора и эмиттера

10 мА

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 1$ мкс, $Q \geq 2$

20 мА

Постоянная рассеиваемая мощность

при $T \leq 333$ К

150 мВт

при $T = 398$ К 2T301Г, 2T301Д, 2T301Е, 2T301Ж

42 мВт

при $T = 358$ К КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж

58 мВт

Температура перехода

2T301Г, 2T301Д, 2T301Е, 2T301Ж

423 К

КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж

393 К

Общее тепловое сопротивление

0,6 К/мВт

Температура окружающей среды

2T301Г, 2T301Д, 2T301Е, 2T301Ж

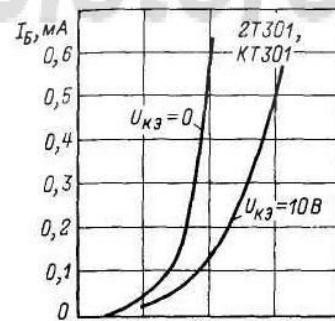
От 213 до 398 К

КТ301Г, КТ301Д, КТ301Е, КТ301Ж

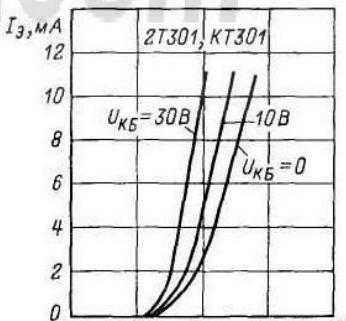
От 233 до 358 К

Примечание При монтаже допускается пайка выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Пайку следует производить паяльником за время не более 10 с. Температура пайки не должна превышать 533 К. Необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом и местом пайки.

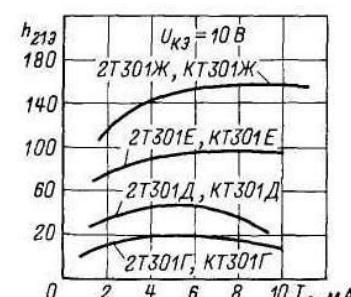
Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора, при этом должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность выводов между местом изгиба и стеклянным изолятором, чтобы не произошло нарушения спая вывода со стеклянным изолятором, ведущего к потере герметичности транзистора.



Входные характеристики



Зависимость тока эмиттера от напряжения эмиттер-база



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер